

بررسی ابتدا به ساکن خواص مکانیکی و گرمایی نانولوله‌های GaN با استفاده از محاسبات فونونی

فرامرز کنجوری^۱، حسن تشکری^۲، عاطفه نجاتی^۳

۱. گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، کرج

۲. دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

۳. آزمایشگاه فیزیک محاسباتی، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم

پست الکترونیکی: tashakori@qom-iau.ac.ir

(دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۶/۴؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۲/۲/۲۷)

چکیده

در این مقاله با استفاده از نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو، خواص فونونی نانولوله‌های GaN، زیگزاگ (۴۰) و دسته‌صندلی (۴۴)، محاسبه و بررسی شده است. با استفاده از نمودار پراکندگی فونونی، پایداری این نانولوله‌ها بررسی شده است. سپس با استفاده از نتایج محاسبات فونونی، ظرفیت گرمایی ویژه در دماهای متفاوت محاسبه شدند. ثابت کشسانی در راستای محور نانولوله با محاسبه شیب نمودار پراکندگی فونونی تعیین شد.

واژه‌های کلیدی: نانولوله‌های تک‌دیواره GaN، زیگزاگ و دسته‌صندلی، کوانتوم اسپرسو، خواص فونونی، خواص مکانیکی، خواص گرمایی

۱. مقدمه

در دو دهه اخیر نانولوله‌های کربنی به سبب خواص منحصر به فردشان مورد توجه بسیاری از محققان در حوزه علوم و مهندسی قرار گرفته‌اند [۱-۵]. خواص الکترونی متمایز نانولوله‌های کربنی به ازای قطر و کایرالیته‌های متفاوت باعث ایجاد انگیزه برای مطالعه و بررسی دیگر نانولوله‌های دو عنصری مانند BN، SiC، TiB₂ شده است [۶-۸]. یکی از این نانولوله‌های دو عنصری GaN است که در سال ۱۹۹۹ احتمال

ساخت آن به صورت نظری تأیید و در سال ۲۰۰۳ به صورت تجربی ساخته شد [۹ و ۱۰]. این نانولوله به دلیل کاربرد گسترده در زمینه‌های مختلف از جمله لیزرهای GaN، قطعات اسپینترونیکی، دیودهای نوری با رنگ‌های متفاوت از آبی تا قرمز و ترانزیستورها بسیار مورد توجه واقع شده است [۱۱]. با توجه به مطالعات نظری، این نانولوله‌ها مستقل از کایرالیته‌شان، نیمه‌رساناهایی با گاف نسبتاً پهن هستند [۱۲ و ۱۳]. از این‌رو نانولوله‌های GaN کاندیدای بسیار مناسبی در ساخت آشکارسازها محسوب می‌شوند.

جدول ۱. سرعت مدهای آکوستیکی.

کایرالیته نانولوله GaN	$v_{LA} (\frac{km}{s})$	$v_{TA} (\frac{km}{s})$	$v_{TW} (\frac{km}{s})$
(۴۰)	۱۰,۰۷۱	۶,۳۶۱	۱,۷۰۳
(۴و۴)	۴,۲۲۳	۳,۲۰۹	۲,۱۱۹

به دست آمد و در تطابق خوبی با نتایج دیگران بود [۱۴]. نمودار پراکندگی فونونی، وابستگی بسامد فونون‌ها به بردار موج در راستاهای متفاوت را نشان می‌دهد. چنین اطلاعاتی به صورت تجربی با استفاده از پراکندگی نوترونی و رسم نمودار چگالی حالات فونونی به دست می‌آید. به دلیل مشکلات آزمایشات تجربی، به مطالعه و بررسی نمودار پراکندگی فونونی و چگالی حالات فونونی با استفاده از محاسبات اصول اولیه می‌پردازیم. پس از انجام محاسبات و رسم نمودار پراکندگی فونونی در راستای محور نانولوله، همان طور که انتظار داشتیم، تعداد ۴۸ مد فونونی برای هر دو نانولوله ایجاد می‌گردد (شکل ۱). با توجه به نمودار پراکندگی فونونی، چهار مد آکوستیکی مشاهده می‌شود. یک مد آکوستیکی طولی (LA)، یک مد تبهگن دوگانه آکوستیکی عرضی (TA) و یک مد آکوستیکی پیچشی^۱ است. مد LA مربوط به حرکت اتم‌ها در راستای محور نانولوله، مدهای دوگانه TA که مربوط به جابه‌جایی عمودی اتم‌ها نسبت به محور نانولوله و مد پیچشی مربوط به چرخش نانولوله حول محورش است. بسامدهای فونونی مثبت و حقیقی نشان‌دهنده پایداری نانولوله GaN (۴۰) هستند. این نانولوله دارای دو گاف فونونی از (275 cm^{-1}) تا (376 cm^{-1}) و از (443 cm^{-1}) تا (549 cm^{-1}) است. علت وجود این گاف‌ها، وجود دو نوع اتم در راستای محور نانولوله است، که در یاخته بسیط تکرار می‌شود. در نمودار پراکندگی فونونی نانولوله (۴۰) بسامدهای منفی و موهومی بیانگر ناپایداری این نانولوله هستند.

برای محاسبه سرعت مدهای آکوستیکی از شیب نمودار پراکندگی فونونی $\left(v = \frac{d\omega}{dk}\right)$ شاخه‌های آکوستیکی، استفاده می‌شود (جدول ۱).

تا کنون با وجود بررسی‌های متنوعی که برای خواص الکترونی، ساختاری و مغناطیسی این نانولوله‌ها به صورت خالص، افزودن ناخالصی و کپسوله کردن نانوسیم در آنها انجام شده است، بررسی‌های تجربی و نظری چندانی در زمینه مدهای فونونی و خواص ارتعاشی آنها صورت نگرفته است [۱۴-۱۹].

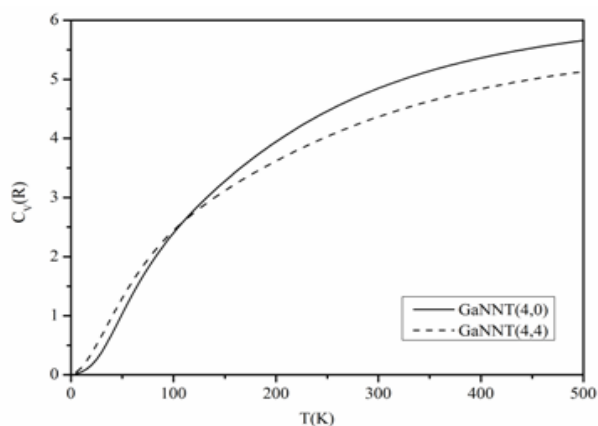
۲. مبانی محاسباتی

خواص نانولوله‌های GaN تک دیواره، زیگزاگ (۴۰) با قطر ۴/۳۰۵ آنگستروم و دسته صندلی (۴و۴) با قطر ۷/۴۸۴ آنگستروم با استفاده از کوانتوم اسپرسو بررسی شده است. به منظور بهینه‌سازی‌های اولیه از همگرایی انرژی استفاده شده است. نانولوله‌های زیگزاگ و دسته صندلی با ۱۲ چرخه، دقت $6/8 \times 10^{-11}$ و 6×10^{-11} ریدبرگ و تعداد ۱۱۰۴۸ و ۱۴۴۰۸ موج تخت همگرا شده‌اند. در این روش، شبه پتانسیل‌های فوق نرم ایجاد شده با تقریب چگالی موضعی (pw91) به کار رفته است. تقسیم‌بندی منطقه بریلوئن به روش مونخورست - پک انجام شده و تعداد نقاط بهینه k برای هر دو نانولوله، $1 \times 1 \times 12$ به دست آمده است. موقعیت اتم‌ها با استفاده از الگوریتم bfg مشخص و واهلش یافته است. برای انجام محاسبات فونونی از کد ph.x استفاده شده است. این کد بر مبنای نظریه تابعی چگالی اختلالی است. با استفاده از قضیه هلمن فاینمن نیروی وارد به هر اتم در یک یاخته محاسبه شده و مدهای ارتعاشی یک بلور یا بسامدهای فونونی به وسیله مدهای ارتعاشی یک سیستم مکانیکی ساده به دست می‌آیند. تعداد نقاط q برای محاسبه ماتریس ثابت‌های نیرو در محاسبات فونونی، برای هر دو نانولوله $3 \times 3 \times 2$ انتخاب شده است.

۳. خواص فونونی

در ابتدا برای انجام محاسبات فونونی، نانولوله‌های GaN (۴۰) و (۴و۴)، با لوله کردن صفحه گرافیت مانند ایجاد می‌شوند. پارامترهای ساختاری بهینه شده، از جمله قطر (۷/۴۸۴ آنگستروم و ۴/۳۰۵ آنگستروم)، دوره تناوب (۳/۱۷۶ آنگستروم و ۵/۳۶۱ آنگستروم) و اختلاف شعاع یا باکلینگ (۰/۱ آنگستروم و ۰/۲۳۵ آنگستروم) به ترتیب برای نانولوله‌های (۴و۴) و (۴۰)

۱. Twist



شکل ۲. نمودار ظرفیت گرمایی ویژه نانولوله‌های GaN (۴۰) و (۴۴) به ازای دماهای متفاوت.

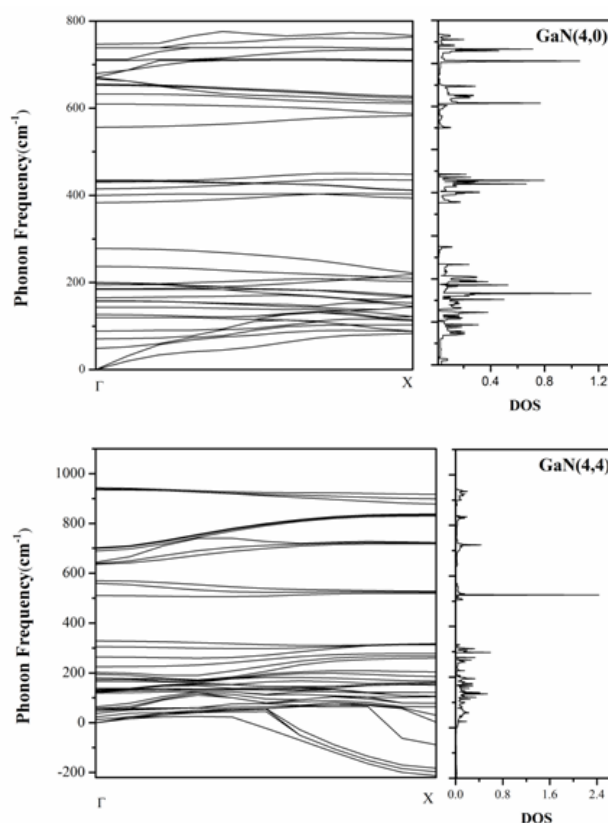
کلاسیکی $3Nk_B = 6R = 49.85 \text{ (J/mol.K)}$ می‌رسد (N تعداد اتم‌ها در یک مولکول). در دماهای پایین دو نمودار تقریباً بر هم منطبق هستند، اما با افزایش دما از هم فاصله می‌گیرند و نانولوله (۴۰) دارای ظرفیت گرمایی بیشتری نسبت به (۴۴) می‌شود، که با توجه به نمودار چگالی حالات فونونی می‌توان این تفاوت را توجیه کرد. ظرفیت گرمایی ویژه برای نانولوله‌های GaN (۴۰) و (۴۴) در دمای اتاق (300 K)، به ترتیب 42.96 J/mol.K و 37.64 J/mol.K است.

۵. خواص مکانیکی

یکی از خواص مکانیکی، ثابت کشسانی است. خواص کشسانی نانولوله را تنها در راستای محور نانولوله بررسی می‌کنیم. این ثابت با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌گردد

$$C_{33} = \rho \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{LA}^2 \quad (2)$$

در رابطه بالا ρ چگالی نانولوله، $\frac{d\omega}{dk}$ شیب نمودار پراکندگی فونونی و C_{33} ثابت کشسانی است. برای محاسبه سطح مقطع و حجم سلول واحد نانولوله و به دست آوردن ρ ، فرض می‌شود نانولوله از لوله کردن صفحه گرافیت مانند ایجاد شده و ضخامت نانولوله نصف پارامتر شبکه در راستای z در فاز وترزیت است (۲۰۲۳، آنگستروم). در جدول ۲ مقدار ثابت کشسانی آورده شده است.



شکل ۳. نمودار پراکندگی فونونی نانولوله‌های GaN (۴۰) و (۴۴).

۴. خواص گرمایی

در حالت کلی، ظرفیت گرمایی ویژه از دو قسمت توزیع الکترونی و فونونی تشکیل شده است. اما در نانولوله‌ها، قسمت توزیع فونونی سهم بیشتری در ظرفیت گرمایی ویژه دارد. این توزیع فونونی با انتگرالگیری بر روی چگالی حالات فونونی به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$C_V = \int_0^{\omega_{\max}} g(\omega) \left(\frac{\hbar\omega}{K_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/K_B T}}{(e^{\hbar\omega/K_B T} - 1)^2} d\omega \quad (1)$$

که در رابطه بالا T دمای مطلق، $g(\omega)$ چگالی حالات فونونی و $\omega_{\max}$ بیشترین بسامد مربوط به فونون‌ها است. با افزایش دما تعداد حالات فونونی اشغال شده و در نتیجه ظرفیت گرمایی افزایش می‌یابد. نمودار ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت بر حسب دما در شکل ۲ رسم شده است. با توجه به نمودار، ظرفیت گرمایی در دماهای پایین با تقریب T^3 دبی مطابقت داشته و در دماهای بالا به مقدار

نانولوله (۴۰) از تکرار منظم N-N-Ga-Ga در نانولوله (۴۴)، در راستای محیط نانولوله پایداری بیشتری ایجاد می‌کند. نانولوله (۴۰) دارای دو گاف فونونی به اندازه‌های 103 cm^{-1} و 108 cm^{-1} است. علت وجود این گاف‌ها، وجود دو نوع اتم در راستای محور نانولوله است که در یاخته بسیط نیز تکرار می‌شوند. ظرفیت گرمایی این نانولوله‌ها در دماهای خیلی پایین، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، درحالی‌که در سایر دماها ($T > 100\text{K}$) ظرفیت گرمایی (۴۰) از (۴۴) بیشتر است. ثابت کشسانی به دست آمده برای هر دو نانولوله به یکدیگر نزدیک است و در راستای محور نانولوله، هر دو به یک اندازه مقاومت دارند.

جدول ۲. چگالی و ثابت‌های کشسانی مربوط به نانولوله‌های GaN (۴۰) و (۴۴).

	(۴۰)	(۴۴)
GaNNT		
$\rho \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right)$	۵۳۵۷	۵۶۷۸
$c_{33} (\text{TPa})$	۰/۵۹	۰/۵۸

۶. نتیجه‌گیری

با توجه به بسامدهای ارتعاشی به دست آمده برای نانولوله‌های GaN (۴۰) و (۴۴)، خواص مکانیکی و گرمایی بررسی شد. نتایج نشان دهنده پایداری نانولوله (۴۰) و ناپایداری نانولوله (۴۴) است. به نظر می‌رسد تکرار منظم اتم‌های Ga-N در

مراجع

1. P M Ajayan and T W Ebbesen, *Rep. Prog. Phys.* **60** (1997) 1025.
2. Z L Wang, P Poncharal, and W A De Heer, *J. Phys. Chem. Solids* **61** (2000) 1025.
3. S S Xie, W Z Li, Z W Pan, B H Chang, and L F Sun, *J. Phys. Chem. Solids* **61** (2000) 1153.
4. Y Wu, H Yan, M Huang, B Messer, J Song, and P Yang, *Chem. Eur.* **8** (2002) 1260.
5. P D Yang, *et al.*, *J. Adv. Funct. Mater.* **12** (2002) 323.
6. N G Chopra, *et al.*, *Science* **269** (1995) 966.
7. A Gali, *Phys. Rev. B* **73** (2006) 245415.
8. S Meng, E Kaxiras, and Z Zhang, *Nano Lett.* **7** (2007) 663.
9. S M Lee, Y H Lee, Y G Hwang, J Elsner, D Porezag, and Th Frauenheim, *Phys. Rev. B* **60** (1999) 7788.
10. J Golberger, R He, Y Zhang, S Lee, H Yan, H-J Choi, and P Yang, *Nature* **422** (2003) 599.
11. H Morkoç, *et al.*, *Appl. Phys.* **76**, 3 (1994) 1363.
12. S M Lee, Y G Hwang, J Elsner, D Porezag, and T Frauenheim, *Phys. Rev. B* **60** (1999) 7788.
13. M Zhang, Z M Su, L K Yan, Y Q Qiu, G H Chen, and R S Wang, *Chem. Phys. Lett.* **408** (2005) 145.
14. Y H Guo, M X Chen, Z H Guo, and X H Yan, *Phys. Lett. A* **372** (2008) 2688.
15. Q Sun, A Selloni, T H Myers, and W A Doolittle, *Phys. Rev. B* **73** (2006) 155337.
16. Q Sun, A Selloni, T H Myers, and W Alan Doolittle, *Phys. Rev. B* **74** (2006) 195317.
17. A L Rosa, J Neugebauer, *Phys. Rev. B* **73** (2006) 205314.
18. G X Cen, Y Zhang, D D Wang, J M Zhang, and K W Xu, *Computational and Theoretical Chemistry* **963** (2011) 18.
19. L C Ma, Y Zhang, J M Zhang, and K W Xu, *Physica B* **406** (2011) 3502.